

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2001-334689  
起案日 平成15年 4月30日  
特許庁審査官 正山 旭 9276 4M00  
特許出願人代理人 井上 一 (外 2名) 様  
適用条文 第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理 由

A. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1～18
- ・理由 A
- ・引用文献等 1, 2, 3, 4
- ・備考

引用文献1には、CMOS型SRAMセルにおいて、フィールド絶縁膜上に設けられた第1層導電層と、前記第1層導電層より上の層に位置する第2層導電層と、前記第1層導電層と前記第2層導電層との間に設けられた第1層間絶縁層にスルーホールが形成されていることが記載されている。(特に、第2図、第3図及び図面説明箇所参照。)

引用文献2には、第1層間絶縁膜に設けられた第1スルーホールの穴径が、第1層間絶縁層より上に位置する層間絶縁膜に設けられたスルーホールの穴径以下であることが記載されている。(特に、第3図～第7図及び図面説明箇所参照。)

引用文献3には、ゲートゲート電極層とドレインードレイン配線層、2つのドレインゲート配線層からなるCMOS型SRAMセルが記載されている。(特に、第1図～第8図及び図面説明箇所参照。)

1層目のマスク層の開口部に、2層目のマスク層を用いて側壁を形成して、スルーホールを形成することについては、引用文献4の、特に、第6図～第8図及



び図面説明箇所を参照されたい。

## 引用文献等一覽

1. 特開 2 0 0 0 - 0 3 6 5 4 2 号公報
2. 特開平 0 3 - 0 4 0 4 4 9 号公報
3. 特開 2 0 0 0 - 2 6 9 3 1 9 号公報 ✓
4. 特開平 1 0 - 2 9 4 3 6 7 号公報

B. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていない。

## 記

・請求項7

本請求項には「リラックス層」という記載があるが、「リラックス層」が何なのか不明瞭である。

・請求項 1 4

本請求項には、「前記第3導電層」という記載があるが、「前記」に対応する文言がない。

・請求項 8 ～ 13, 15 ～ 18

本請求項は、不明瞭な記載を有する請求項 7, 14 を引用しているため、同様に不明瞭である。

よって、請求項 7～18 に係る発明は明確でない。

## 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野      I P C第7版   H 0 1 L 2 7 / 1 1

H 0 1 L 2 1 / 8 2 4 4

・先行技術文献

特開平07-231044号公報／

特開平09-260510号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

